05:07:12

## Определение теплофизических характеристик и параметров трещин в керамиках лазерным фотодефлекционным методом

© К.Л. Муратиков, А.Л. Глазов

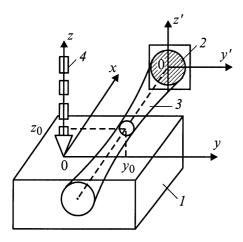
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, 194021 Санкт-Петербург, Россия

(Поступило в Редакцию 16 мая 2000 г.)

Разработана модель образования фотодефлекционного сигнала в керамиках. Рассмотрена задача генерации температурных волн лазерным излучением в керамиках с учетом возможной анизотропии их теплофизических свойств. Фотодефлекционным методом выполнены измерения теплофизических параметров на керамике нитрида кремния. Показано, что фотодефлекционный метод может быть использован для обнаружения и определения параметров подповерхностных трещин в керамиках.

Изучению и измерению теплофизических свойств современных керамик уделяется значительное внимание [1,2]. Интерес к их изучению обусловлен сочетанием таких важных свойств, как твердость, износостойкость, устойчивость к коррозии, низкая плотность и возможность использования при высоких температурах. При этом важное значение имеет как изучение свойств однородных керамик, так и диагностика образования в них возможных дефектов. Одним из наиболее важных и трудно детектируемых дефектов в керамиках являются подповерхностные трещины [3-6]. В связи с этим в данной работе разработан подход к решению указанных проблем с помощью лазерного фотодефлекционного метода [7,8]. В работе [9] был предложен модифицированный фотодефлекционный метод, основанный на использовании понятий волновой оптики и позволяющий производить теплофизические измерения в широком диапазоне температурных волн.

Особенности образования фотодефлекционного сигнала в рамках волновой оптики были проанализированы в работах [10–12]. В этих работах были подробно исследованы дифракционные эффекты зондирующего ла-



**Рис. 1.** Схема термофотодефлекционного эксперимента: I — исследуемый объект, 2 — фотодетектор, 3 — считывающий лазерный луч, 4 — греющее излучение.

зерного излучения на нестационарной тепловой линзе, создаваемой вблизи исследуемого объекта излучением накачки, и показана важность их учета при определении фотодефлекционного сигнала. В связи с этим в данной работе детали расчета фотодефлекционного сигнала в рамках указанной модели не рассматриваются.

Для типичной геометрии расположения лазерных пучков и образца (рис. 1) при проведении фотодефлекционных экспериментов выражения для нормальной и тангенциальной компонент фотодефлекционного сигнала в соответствии с результатами работ [10–12] могут быть представлены в виде

$$S_{n} = \frac{KI_{0}}{\lambda r \sqrt{\pi}} \frac{\partial n}{\partial T} \int_{0}^{\infty} dz \int dk_{y} \exp\left[ik_{y}y_{0} - \gamma_{g}z\right]$$

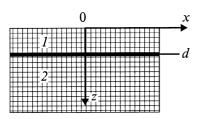
$$-\frac{k_{y}^{2}r^{2}}{4} - \frac{(z - z_{0})^{2}}{r^{2}} \operatorname{erfi}\left(\frac{z - z_{0}}{r\sqrt{2}}\right) \hat{T}_{s}(0, k_{y}, \omega), \quad (1)$$

$$S_{t} = \frac{KI_{0}}{2\lambda r \sqrt{\pi}} \frac{\partial n}{\partial T} \int dy \int dk_{y} \exp\left[ik_{y}y - \gamma_{g}z_{0}\right]$$

$$+ \frac{\gamma_{g}^{2}r^{2}}{4} - \frac{(y - y_{0})^{2}}{r^{2}} \operatorname{erfi}\left(\frac{y - y_{0}}{r\sqrt{2}}\right)$$

$$\times \left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{z_{0}}{r} - \frac{\gamma_{g}r}{2}\right)\right] \hat{T}_{s}(0, k_{y}, \omega), \quad (2)$$

где K — коэффициент пропорциональности между интенсивностью света на фотоприемнике и электрическим сигналом;  $I_0$  — интенсивность излучения зондирующего лазера;  $\partial n/\partial T$  — коэффициент, характеризующий скорость изменения показателя преломления среды вблизи объекта с температурой;  $\lambda$  — длина волны излучения зондирующего лазера;  $\hat{T}_s(k_x,k_y,\omega)$  — фурье-образ по координатам x и y от нестационарной составляющей температуры поверхности объекта  $T_s(x,y,0,\omega)$ ;  $\omega=2\pi f,\ f$  — частота модуляции возбуждающего излучения; r — радиус его пучка в фокальной плоскости;  $\gamma_g=\sqrt{k_y^2+(i\omega/\kappa_g)},\ \kappa_g$  — коэффициент температуропроводности среды вблизи объекта;  $y_0$  — поперечное



**Рис. 2.** Схема образца с горизонтальной трещиной на глубине d между слоями 1 и 2.

смещение пучка зондирующего лазера относительно центра тепловой линзы;  $z_0$  — высота его прохождения над поверхностью образца,

$$\operatorname{erfi}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{0}^{x} \exp(x^{2}) dx, \quad \operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{0}^{x} \exp(-x^{2}) dx.$$

В соответствии с выражениями (1) и (2) для определения фотодефлекционных сигналов необходимо знать нестационарную составляющую температуры поверхности объекта. Для ее определения в свою очередь необходимо исследовать процессы генерации температурных волн и их распространения в объекте и окружающей его среде. Для анализа поведения температурных волн в объектах с подповерхностными трещинами воспользуемся двуслойной моделью (рис. 2). В этой модели предполагается, что трещина залегает на глубине z = d. этом будем считать, что ширина трещины значительно меньше длины температурной волны. Тогда ее присутствие можно характеризовать с помощью некоторого теплового сопротивления, расположенного на границе z = d. Кроме того, для общности будем считать, что слои 1 и 2, вообще говоря, характеризуются различными теплофизическими свойствами.

Большинство керамик по своим теплофизическим свойствам является анизотропными материалами. Более точно их обычно можно отнести к классу ортотропных материалов, для которых характерно совпадение двух главных значений тензора теплопроводности в одной из плоскостей и другое главное значение тензора теплопроводности в направлении оси, препендикулярной к этой плоскости. Расположение указанных плоскостей и осей в реальной керамике определяется направлением горячего прессования при ее изготовлении. В данной работе будем предполагать, что плоскости с одинаковыми главными значениями тензора теплопроводности расположены параллельно плоскости z=0.

Для сформулированной задачи уравнения теплопроводности для газовой среды, окружающей образец, и его первой и второй областей могут быть представлены в следующем виде:

$$\rho_g C_g \frac{\partial T_g}{\partial t} = K_g \left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) T_g, \tag{3}$$

$$\rho_1 C_1 \frac{\partial T_1}{\partial t} = K_1^{(\parallel)} \frac{\partial^2 T_1}{\partial z^2} + K_1^{(\perp)} \left( \frac{\partial^2 T_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T_1}{\partial y^2} \right) + \alpha I_p(x, y, t) e^{-\alpha z}, \tag{4}$$

$$\rho_2 C_2 \frac{\partial T_2}{\partial t} = K_2^{(\parallel)} \frac{\partial^2 T_2}{\partial z^2} + K_2^{(\perp)} \left( \frac{\partial^2 T_2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T_2}{\partial y^2} \right), \quad (5)$$

где  $\rho_g, \rho_1, \rho_2$  и  $C_g, C_1, C_2$  — плотности и удельные теплоемкости воздуха и материала образца в первой и воторой областах соответственно;  $K_g$  — теплопроводность воздуха;  $K_1^{(\perp)}, K_2^{(\perp)}$  и  $K_1^{(\parallel)}, K_2^{(\parallel)}$  — компоненты тензора теплопроводности в плоскости (x,y) и вдоль оси z для первой и второй областей материала;  $\alpha$  — коэффициент поглощения образцом излучения возбуждающего лазера;  $I_p(x,y,t)$  — распределение интенсивности излучения возбуждающего лазера на поверхности образца.

Отметим, что в фотодефлекционных экспериментах возбуждение температурных волн в образце обычно производится излучением, сильно поглощающимся в образце. Поэтому в уравнениях (4) и (5) считается, что возбуждающее излучение полностью поглощается в первом слое объекта.

Для решения поставленной задачи помимо уравнений теплопроводности необходимо задать граничные условия. Для нашей модели граничные условия на поверхности z=0 и z=d могут быть записаны в следующем виде:

$$T_1 = T_g \Big|_{z=0}, \quad K_1^{(\parallel)} \frac{\partial T_1}{\partial z} = K_g \frac{\partial T_g}{\partial z} \Big|_{z=0},$$

$$K_1^{(\parallel)} \frac{\partial T_1}{\partial z} = K_2^{(\parallel)} \frac{\partial T_2}{\partial z} \bigg|_{z=d}, \ T_1 - T_2 = -R_t K_1^{(\parallel)} \frac{\partial T_1}{\partial z} \bigg|_{z=d}, \ (6)$$

где  $R_t$  — тепловое сопротивление между первой и второй областями объекта.

Решение уравнений (3)–(5) удобно искать методом преобразования Фурье по координатам, лежащим в плоскости поверхности объекта, с помощью равенства

$$T(x, y, z, t) = \int dk_x \int dk_y e^{ik_x x + ik_y y} \hat{T}(k_x, k_y, z, t), \quad (7)$$

где  $\hat{T}(k_x, k_y, z, t)$  — фурье-образ по координатам x и y от нестационарной составляющей температуры.

В данной работе предполагается, что возбуждение температурных волн производится под действием периодического источника тепла. Поэтому в дальнейшем будем считать, что изменение температуры со временем происходит по гармоническому закону  $e^{i\omega t}$ . В этом случае уравнение для фурье-образа температуры, например, для первой области образца может быть представлено в

следующей форме:

$$\frac{i\omega}{\kappa_1^{(\parallel)}} \hat{T}_1(k_x, k_y, z, \omega) = \left[ -\frac{K_1^{(\perp)}}{K_1^{(\parallel)}} \left( k_x^2 + k_y^2 \right) + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right] 
\times \hat{T}_1(k_x, k_y, z, \omega) + \frac{\alpha \hat{I}_p(k_x, k_y) e^{-\alpha z}}{K_1^{(\parallel)}},$$
(8)

где  $\hat{I}_p(k_x,k_y)$  — фурье-образ распределения интенсивности излучения возбуждающего лазера на поверхности образца.

Уравнение для фурье-образов температур  $\hat{T}_g$  и  $\hat{T}_2$  могут быть получены аналогичным образом. Будем считать, что распределение интенсивности излучения возбуждающего лазера на поверхности образца подчиняется гауссовскому закону, т.е. имеет вид

$$I_p(x,y) = \frac{W_0}{\pi a^2} e^{-\frac{x^2 + y^2}{a^2}},$$
 (9)

где  $W_0$  — мощность возбуждающего лазерного пучка, a — его радиус в фокусе пучка.

Тогда фурье-образ распределения интенсивности излучения возбуждающего лазера определяется равенством

$$\hat{I}_p(k_x, k_y) = \frac{W_0}{(2\pi)^2} e^{-\frac{a^2(k_x^2 + k_y^2)}{4}}.$$
 (10)

Для определения нестационарной составляющей температуры поверхности объекта и в соответствии с выражениями (1) и (2) нормальной и тангенциальной компонент фотодефлекционного сигнала необходимо решить уравнения теплопроводности (3)—(5) с граничными условиями (6). Решение этой задачи в явной форме может быть представлено в следующей форме:

$$\hat{T}_g(k_x, k_y, z, \omega) = Ge^{q_g z}, \tag{11}$$

$$\hat{T}_1(k_x, k_y, z, \omega) = F_1 e^{q_1 z} + F_2 e^{-q_1 z} + A e^{-\alpha z}, \tag{12}$$

$$\hat{T}_2(k_x, k_y, z, \omega) = Se^{-q_2 z},$$
 (13)

где

$$\begin{split} q_g &= \sqrt{\frac{i\omega}{\kappa_g} + k_x^2 + k_y^2}, \quad q_{1,2} &= \sqrt{\frac{i\omega}{\kappa_{1,2}^{(\parallel)}} + \frac{K_{1,2}^{(\perp)}}{K_{1,2}^{(\parallel)}} \left(k_x^2 + k_y^2\right)}, \\ G &= A \left( \operatorname{ch} q_1 d \, \frac{q_1 K_1^{(\parallel)} P e^{-\alpha d} - N \left(\alpha K_1^{(\parallel)} + q_g K_g\right)}{NM + q_1 K_1^{(\parallel)}} + 1 \right), \\ A &= \frac{\alpha \hat{I}_p}{K_1^{(\parallel)}} \, \frac{1}{\frac{i\omega}{\kappa_1^{(\parallel)}} + \frac{K_1^{(\perp)}}{K_1^{(\parallel)}} \left(k_x^2 - k_y^2\right) - \alpha^2}, \\ F_1 &= \frac{1}{2} \, \frac{A}{NM + q_1 K_1^{(\parallel)}} \left[ \left(\alpha K_1^{(\parallel)} + q_g K_g\right) \left(1 - N e^{-q_1 d}\right) + P e^{-\alpha d} \left(M + q_1 K_1^{(\parallel)} e^{-q_1 d}\right) \right], \end{split}$$

$$\begin{split} F_2 &= \frac{1}{2} \frac{A}{NM + q_1 K_1^{(\parallel)}} \Big[ - \big( \alpha K_1^{(\parallel)} + q_g K_g \big) \big( 1 + N e^{q_1 d} \big) \\ &\quad + P e^{-\alpha d} \big( q_1 K_1^{(\parallel)} e^{q_1 d} - M \big) \Big], \\ S &= - \frac{q_1 K_1^{(\parallel)}}{q_2 K_2^{(\parallel)}} \frac{MA}{NM + q_1 K_1^{(\parallel)}} e^{q_2 d} \operatorname{ch} q_1 d \left( \frac{\alpha K_1^{(\parallel)} + q_g K_g}{M} \right) \\ &\quad + P e^{-\alpha d} + \frac{\alpha A K_1^{(\parallel)}}{q_2 K_2^{(\parallel)}} e^{-(\alpha + q_2) d}, \\ M &= q_g K_g \operatorname{ch} q_1 d + q_1 K_1^{(\parallel)} \operatorname{sh} q_1 d, \\ N &= \operatorname{sh} q_1 d + \Big( 1 + R_t q_2 K_2^{(\parallel)} \Big) \frac{q_1 K_1^{(\parallel)}}{q_2 K_2^{(\parallel)}} \operatorname{ch} q_1 d, \\ P &= \frac{\alpha K_1^{(\parallel)}}{q_2 K_2^{(\parallel)}} \Big( 1 + R_t q_2 K_2^{(\parallel)} \Big) - 1. \end{split}$$

Нестационарная составляющая температуры поверхности объекта может быть определена из уравнений (11) и (12), если в них положить z=0. К сожалению, получающиеся при этом для фотодефлекционного сигнала выражения являются достаточно сложными и не могут быть выражены в аналитической форме. В связи с этим нами была разработана компьютерная программа для определения нормальной и тангенциальной компонент фотодефлекционного сигнала.

Поставленная задача может быть решена также в рамках понятий теории рассеяния температурных волн. Для этого необходимо ввести понятия падающей, прошедшей и отраженной температурных волн, а также определить коэффициенты отражения и пропускания температурных волн на границах раздела [15]. В данном рассмотрении обобщим результаты работы [13] на случай, когда излучение возбуждающего лазера проникает в образец, а также когда на границе областей образца имеется тепловое сопротивление.

В общем случае падающая и отраженная вдоль оси z от границы z=d волны, а также волна, прошедшая во вторую область образца, могут быть определены с помощью равенства

$$\hat{I}_1(k_x, k_y, z) = C_I e^{q_1 z}$$
 при  $0 \leqslant z \leqslant d$ , (14)

$$\hat{R}_1(k_x, k_y, z) = C_R e^{-q_1 z}$$
 при  $0 \le z \le d$ , (15)

$$\hat{T}_2(k_x, k_y, z) = C_T e^{q_2 z}$$
 при  $d \leqslant z \leqslant \infty$ , (16)

где  $C_I$ ,  $C_R$ ,  $C_T$  — некоторые коэффициенты, зависящие от компонент волнового вектора  $k_x$  и  $k_y$ .

В соответствии с этими выражениями падающая волна определяется равенством (14), отраженная — (15) и прошедшая — (16). Результирующая температурная волна в первом слое может быть представлена с помощью выражений (14) и (15) в виде

$$\hat{T}_1(k_x, k_y, z) = C_I e^{q_1 z} + C_R e^{-q_1 z}. \tag{17}$$

В соответствии с определением коэффициенты отражения и пропускания температурных волн [13] задаются с помощью равенств

$$\hat{R}_{12}(k_x, k_y) = \frac{\hat{R}_1(k_x, k_y, d)}{\hat{I}_1(k_x, k_y, d)} = \frac{C_R}{C_I},$$
(18)

$$\hat{T}_{12}(k_x, k_y) = \frac{\hat{T}_2(k_x, k_y, d)}{\hat{T}_1(k_x, k_y, d)} = \frac{C_T}{C_I}.$$
 (19)

С использованием граничных условий (6) и уравнений (16), (17) эти выражения в явном виде могут быть представлены в следующей форме:

$$\hat{R}_{12} = \frac{1 - \xi_{12} (1 - R_t q_1 K_1^{(\parallel)})}{1 + \xi_{12} (1 + R_t q_1 K_1^{(\parallel)})},$$

$$\hat{T}_{12} = \frac{2}{1 + \xi_{12} + R_t q_2 K_2^{(\parallel)}},$$
(20)

где

$$\xi_{12} = \frac{q_2 K_2^{(\parallel)}}{q_1 K_1^{(\parallel)}}.$$

Для случая  $R_t = 0$  эти выражения совпадают с результатами работы [15], в которой были найдены коэффициенты отражения и пропускания температурных волн от плоской границы раздела при отсутствии теплового сопротивления.

Температура поверхности объектов может быть найдена с учетом эффекта многократного отражения температурных волн от границ раздела z=0 и z=d, а также их интерференции на границе z=0 [13]. При использовании такого подхода температура поверхности объекта может быть определена с помощью равенства

$$\hat{T}_{1}(k_{x}, k_{y}, 0, \omega) = \frac{\alpha \hat{I}_{p} \hat{T}_{1g}}{2q_{1} K_{1}^{(\parallel)} (1 - \hat{R}_{1g} \hat{R}_{12} e^{-2q_{1}d})} \times \int_{0}^{d} dz \Big[ e^{-q_{1}z} + \hat{R}_{12} e^{-q_{1}(2d-z)} \Big], \quad (21)$$

где

$$\hat{T}_{1g} = rac{2}{1+\xi_{1g}}, \quad \xi_{1g} = rac{q_g K_g}{q_1 K_1^{(\parallel)}}, \quad \hat{R}_{1g} = rac{1-\xi_{1g}}{1+\xi_{1g}}.$$

После подстановки значений коэффициентов пропускания и отражения (20) в выражение (21) температуру поверхности образца получим в следующем виде:

$$\hat{T}_{1}(k_{x}, k_{y}, 0, \omega) = \frac{\alpha \hat{I}_{p}}{(\alpha^{2} - q_{1}^{2})K_{1}^{(\parallel)}} 
\times \frac{(r-1)[1 + \xi_{12}(1 + R_{t})][1 - e^{-(\alpha + q_{1})d}] + (r+1)[1 + \xi_{12}(R_{t} - 1)][e^{-2q_{1}d} - e^{-(\alpha + q_{1})d}]}{(1 + \xi_{1g})[1 + \xi_{12}(1 + R_{t})] + (1 - \xi_{1g})[1 + \xi_{12}(R_{t} - 1)]e^{-2q_{1}d}},$$
(22)

где  $r = \alpha/q_1$ .

Отметим, что выражение (22) для температуры поверхности образца совпадает с соответствующей температурой, получаемой путем прямого решения уравнений теплопроводности (3)–(5) и даваемой равенствами (11) или (12). При  $R_t=0$  выражение (22) совпадает с результатом, полученным ранее в работе [13]. Кроме того, отметим, что сформулированный подход помимо температуры поверхности объекта позволяет также найти коэффициенты отражения и прохождения температурных волн через границу раздела в образце при наличии у нее теплового сопротивления.

При известном значении фурье-образа температуры поверхности объекта, даваемом выражениями (12) или (22), в соответствии с равенствами (1) и (2) можно найти нормальную и тангенциальную компоненты фотодефлекционного сигнала. Возможность определения фотодефлекционного сигнала может быть использована для решения нескольких задач.

Во-первых, полученные результаты могут бытьо использованы для определения значений температуропроводности объекта фотодефлекционным методом. В данной работе они использованы для определения теплофизических параметров керамики нитрида кремния. Для решения этой задачи экспериментально снималась зависимость нормальной и тангенциальной компонент фотодефлекционного сигнала от частоты возбуждающего излучения или расстояния между пучками возбуждающего и считывающего лазеров. После этого с помощью выражений (1) и (2) производился компьютерный расчет фотодефлекционных сигналов и путем варьирования значений температуропроводностей  $\kappa^{(\perp)}$  и  $\kappa^{(||)}$  находилась наименьшая среднеквадратичная ошибка между измеренными и теоретическими результатами. Подобная процедура ранее нами была апробирована на различных объемных материалах и тонких пленках [14,15].

В ходе экспериментов на керамике нитрида кремния для возбуждения температурных волн в образцах использовалось излучение аргонового лазера с длиной волны  $\lambda = 0.512 \,\mu\text{m}$ , сфокусированное на поверхность образца в пятно с радиусом около  $2 \, \mu$ m. В качестве считывающего использовался Не-Ne лазер с длиной волны  $\lambda = 0.6328 \, \mu \text{m}$ . Радиус пучка считывающего лазера в области перетяжки составлял  $42 \, \mu \text{m}$ , а сам пучок проходил над поверхностью образца примерно на высоте  $160 \, \mu \text{m}$ . На рис. 3 представлены результаты экспериментальных измерений и теоретических расчетов поведения нормальной составляющей фотодефлекционного сигнала в зависимости от частоты модуляции возбуждающего излучения. На рис. 4 и 5 представлены аналогичные результаты для зависимости нормальной и тангенциальной составляющих фотодефлекционного сигнала от расстояния между считывающим и возбуждающим лазерными пучками при фиксированной частоте модуляции возбуждающего излучения. Минимальное значение среднеквадратичной ошибки для отклонения между теоретическими и экспериментальными результатами как для случая нормальной, так и тангенциальной компонент

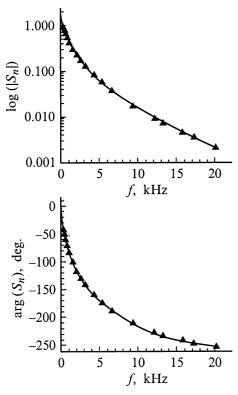
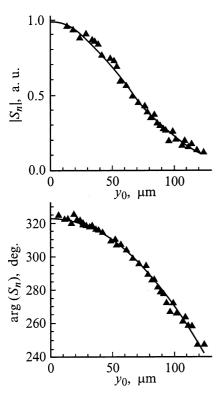
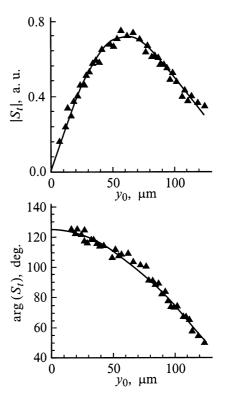


Рис. 3. Зависимость амплитуды и фазы нормальной компоненты фотодефлекционного сигнала от частоты модуляции греющего излучения. ▲ — данные эксперимента, сплошная кривая — теоретический результат после подгонки модельных параметров для однородного образца.



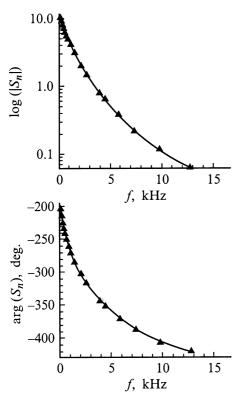
**Рис. 4.** То же, что и на рис. 3. Частота модуляции греющего излучения 9825 Hz.



**Рис. 5.** То же, что и на рис. 3, для тангенциальной компоненты фотодефлекционного сигнала. Частота модуляции греющего излучения 9825 Hz.

фотодефлекционного сигнала достигалось при значениях  $\kappa^{(\perp)}=0.18\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$  и  $\kappa^{(\parallel)}=0.13\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$ . Отметим, что полученные результаты находятся в хорошем количественном соответствии с известными из литературы [2] данными для керамики нитрида кремния  $\kappa^{(\perp)}=0.169\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$  и  $\kappa^{(\parallel)}=0.1237\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$ .

Во-вторых, данные фотодефлекционных измерений могут быть использованы для определения параметров подповерхностных трещин в керамиках. Для исследования этого вопроса были проведены фотодефлекционные эксперименты на керамиках, индентированных по методу Виккерса. Индентирование приводит к образованию в керамике подповерхностных боковых трещин [5]. Для оценки их влияния на фотодефлекционный сигнал были проведены эксперименты на керамике нитрида кремния, индентированной по Виккерсу с нагрузкой 98 N. При этом длина стороны отпечатка составляла  $72 \, \mu \text{m}$ . Измерение фотодефлекционного сигнала производилось на расстоянии  $60\,\mu{\rm m}$  от центра отпечатка, отсчитанном вдоль медианы между радиальными трещинами. Для указанной точки было выполнено измерение нормальной составляющей фотодефлекционного сигнала в зависимости от частоты модуляции возбуждающего излучения. Результаты измерений и теоретических расчетов показаны на рис. 6. При этом минимальная среднеквадратичная ошибка была достигнута при  $R_t \cong 0.27 \, {\rm cm}^2 {\rm K/W}$  и  $d = 22 \, \mu {\rm m}$ . Если использовать соотношение  $R_t = d/K_g$ , которое справедливо при длине



**Рис. 6.** Зависимость амплитуды и фазы нормальной компоненты. ▲ — данные эксперимента, кривая — теоретический результат после подгонки модельных параметров для образца с горизонтальной трещиной.

температурных волн много больше ширины трещины, то для ширины трещины получим значение  $0.6\,\mu\mathrm{m}$ . Полученный результат хорошо согласуется с типичными для керамик значениями, характеризующими степень раскрытия трещин [16].

При решении двух предыдущих задач в ходе теоретического анализа фотодефлекционного сигнала для простоты делалось предположение о том, что излучение возбуждающего лазера полностью поглощается на поверхности образца. Однако поскольку в известной нам литературе отсутствуют какие-либо данные о коэффициенте поглощения излучения аргонового лазера в керамике нитрида кремния, то нами было проведено дополнительное исследование этого вопроса для оценки величины коэффициента поглощения излучения с длиной волны  $\lambda=0.512\,\mu\mathrm{m}$  в этой керамике.

С этой целью были выполнены измерения нормальной и тангенциальной компонент фотодефлекционного сигнала для керамики нитрида кремния в широком диапазоне частот модуляции возбуждающего излучения от 1 до 20 kHz. Теоретический анализ полученных экспериментальных результатов осуществлялся на основе выражений (1) и (2) путем минимизации среднеквадратичных отклонений при варьировании коэффициента поглощения света в этих выражениях. В результате выполнения описанной процедуры нами было получено, что коэффициент поглощения излучения аргонового лазера

в керамике нитрида  $\alpha>3\cdot 10^3\,{\rm cm}^{-1}$ . Анализ степени влияния коэффициента поглощения излучения возбуждающего лазера на результаты фотодефлекционных измерений теплофизических параметров и параметров подповерхностных боковых трещин показывает, что при такой величине  $\alpha$  учет проникновения света в керамику практически не влияет на полученные результаты. В связи с этим при проведении фотодефлекционных измерений на керамике нитрида кремния с генерацией температурных волн излучением с  $\lambda=0.512\,\mu{\rm m}$  характер возбуждения температурных волн может рассматриваться как чисто поверхностный процесс.

Таким образом, полученные в данной работе теоретические и экспериментальные результаты показывают, что фотодефлекционные измерения могут быть использованы для определения теплофизических параметров современных керамик, а также определения и оценки параметров подповерхностных трещин.

## Список литературы

- Hasselman D.P.H., Johnson L.F., Bentsen L.D. et al. // Am. Ceram. Soc. Bull. 1987. Vol. 66. N 5. P. 799–806.
- [2] Chudecki J.F. // Bull. Am. Ceram. Soc. 1990. Vol. 69. N 7. P. 1113–1115.
- [3] Grice K.R., Inglehart L.J., Favro L.D. et al. // J. Appl. Phys. 1983. Vol. 54. N 11. P. 6245–6255.
- [4] Rantala J., Hartikainen J., Jaarinen J. // Appl. Phys. A. 1990. Vol. 50. P. 465–471.
- [5] Cook R.F., Pharr G.M. // J. Am. Ceram. Soc. 1990. Vol. 73. N 4. P. 787–817.
- [6] Bashkansky M., Duncan M.D., Kahn M. et al. // Opt. Lett. 1997. Vol. 22. N 1. P. 61–63.
- [7] Jackson W.B., Amer N.M., Boccara A.C., Fournier D. // Appl. Opt. 1981. Vol. 90. N 8. P. 1333–1344.
- [8] Aamodt L.C., Murphy J.C. // J. Appl. Phys. 1981. Vol. 52. N 8. P. 4903–4914.
- [9] Glazov A.L., Muratikov K.L. // Opt. Commun. 1991. Vol. 84. N 5–6. P. 283–289.
- [10] Глазов А.Л., Муратиков К.Л. // ЖТФ. 1993. Т. 63. Вып. 4. С. 160–166.
- [11] Глазов А.Л., Муратиков К.Л. // ЖТФ. 1994. Т. 64. Вып. 4. С. 118–127.
- [12] Glazov A.L., Muratikov K.L. // J. Appl. Phys. 1994. Vol. 76. N 6. P. 3279–3284.
- [13] Bennet C.A., Patty R.R. // Appl. Opt. 1982. Vol. 21. P. 49-54.
- [14] Glazov A.L., Muratikov K.L., Walther H.G. // High Temperatures-High Pressures. 1999. Vol. 31. P. 69–73.
- [15] Glazov A.L., Muratikov K.L. // Opt. Eng. 1997. Vol. 36. N 2. P. 358–362.
- [16] Pezzotti G., Muraki N., Maeda B. et al. // J. Am. Ceram. Soc. 1999. Vol. 82. N 5. P. 1249–1256.